



نانوساختارسازی آند Ni/GDC برای پیل سوختی اکسید جامد دما پایین (LT-SOFC) بوسیله آغشته‌سازی پالادیم

فاطمه سادات ترک‌نیک^{*}، امیر مقصودی‌پور^۱، منصور کیانپورراد^۱ و کیونگ من‌چویی^۲

۱- پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی

۲- مرکز پژوهش پیل سوختی و دانشگاه علم و صنعت پوهانگ، دانشکده علم و مهندسی مواد، کره جنوبی، پوهانگ

تاریخ ثبت اولیه: ۱۳۹۲/۰۴/۰۶، تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: ۱۳۹۲/۰۴/۱۲، تاریخ پذیرش قطعی: ۱۳۹۲/۰۴/۰۴

چکیده

به منظور مطالعه نقش فرآیند نانوساختارسازی بر کارآیی آند سرمت Ni/GDC برای پیل سوختی اکسید جامد دما پایین (LT-SOFC)، ریزساختار آند $\text{NiO}/\text{Ce}_{0.8}\text{Gd}_{0.2}\text{O}_2$ (NiO/GDC20) بوسیله محلول کلرید پالادیم، آغشته‌سازی شد. تاثیر آغشته‌سازی Pd بر کارآیی آندی، با استفاده از آنالیز طیفی‌بینی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)، به کمک پیل پایه-الکتروولتی (EIS)، به کمک پیل پایه-الکتروولتی (EIS)، به کمک تکنیک‌های TEM، SEM، AFM، XPS بررسی شد. نتایج حاکی از تاثیر بخشی شاخص نانوذرات پالادیم آغشته‌سازی شده بر کاهش مقاومت پلاریزاسیون آندی داشت. در این تحقیق نشان داده می‌شود که فرآیند اصلاح نانوساختاری، با احداث نانوشیکه‌ای از پالادیم روی ریزساختار آند سرمت Ni/GDC کارآیی آند LT-SOFC را بطور قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌بخشد.

واژه‌های کلیدی: پیل سوختی اکسید جامد دما پایین، Ni/GDC، آغشته‌سازی، نانوذرات پالادیم، کارآیی آند.

الکتریسیته تبدیل می‌کند [۳]. به دلیل راندمان بالا، نشر کم محصولات جنبی، ابعاد کوچک، بی‌صدایی نسبت به متورهای احتراقی [۴]، سهولت کاربرد و دوام الکتروولتی جامد (نسبت به مایع) و تنوع سوختهای مصرفی [۵]، SOFC تاکنون در زمرة تجهیزات تولید برق موثر به شمار می‌رود. در SOFC، اکسیژن در کاتد، با الکترون‌های [۶] جریان یافته در مدار خارجی، برای تشکیل یون‌های اکسیژن (O^{2-}) واکنش می‌دهد (احیاء O_2 به O^{2-} ، در سطح مشترک الکتروولتی/کاتد)، با دیفوژیون O^{2-} از طریق الکتروولتی به آند [۶] و واکنش با سوخت، H_2O و CO_2 تشکیل می‌شود [۱]. آند SOFC به عنوان محل واکنش

۱- مقدمه

با کاهش منابع انرژی و افزایش آلاینده‌های زیست محیطی، نیل به فناوری‌های انرژی‌پاک، ارزان، کوچک و کارآمد، منجر به تحول تولید انرژی نسبت به منابع سوخت فسیلی، محرك طراحی‌های ساده‌تر و بهبود خواص شیمیایی و فیزیکی مواد شده است. پیل سوختی اکسید جامد (Solid Oxide Fuel Cell: SOFC)، وسیله‌ای است که با تغذیه پیوسته واکنش‌گرها (H_2 و O_2) [۱]، در دمای بالا با کارآیی موثر [۲]، انرژی شیمیایی سوخت گازی (یا گاز طبیعی) را از طریق فرآیند الکتروشیمیایی، به

* عهده‌دار مکاتبات: فاطمه سادات ترک‌نیک

نشانی: کرج، مشکین دشت، پژوهشگاه مواد و انرژی

تلفن: ۰۲۶۳-۶۲۸۰۰۴۰، دورنگار: ۰۲۶۳-۶۲۸۰۰۴۰، پست الکترونیکی: fstorknik@gmail.com

می‌شود [۱۴]. بر اساس تئوری، الکترود نانوساختار، ریزساختاری ایده‌آل با فعالیت الکتروکاتالیزوری و طول TPB بالاست که بواسطه نیاز به استحکام مکانیکی کافی و پایداری در دمای بالا، مناسب به نظر نمی‌رسد، بنابراین، احداث یک نانوسازه روی اسکلت میکروساختار، به نظر دارای استحکام بیشتر می‌آید [۲]. از این‌رو، اتصال نانوذرات به ساختار میکرونی آندهای متداول، با حفظ پایداری مکانیکی آند اولیه، منجر به افزایش فعالیت الکتروکاتالیزوری آند خواهد شد. اگر چه مطالعات بسیاری راجع به ارتقاء الکترودها بواسیله بهینه‌سازی میکروساختار انجام شده است، لیکن تحقیقات متمرکز محدودی، به رسوب نانوذرات روی پایه الکترود متخلخل معطوف شده است [۱۷]. تکنیک رسوب کاتالیزور نانوذره در اسکلت ماده‌ای که قبل از تراحت فرآیند سینترینگ دما بالا قرار گرفته است، آغشته‌سازی یا نفوذکاری نامیده می‌شود [۲]. نانوذرات، با قراردادن قطره‌ای از محلول اکسیدی/فلزی روی الکترود متخلخل [۱۸] و عملیات حرارتی متعاقب در دمایی به مراتب پایین‌تر از دمای لازم برای فرآیند ساخت سرامیک‌های سنتی تشکیل می‌شوند [۲]. این راهکار مهندسی نانومقیاس، با جلب توجهات بسیاری، به عنوان مؤثرترین و کارآمدترین تکنیک در توسعه الکترودهای نانوساختار، به طریقی که با فرآیندهای دما بالا برای الکترودهای استاندارد SOFC امکان‌پذیر نیست، کارآیی بالا و ریزساختاری مفید و باصرف، فراهم می‌سازد [۱۹]. وظیفه نانوذرات، توسعه مراکز واکنش [۲۰] (TPB) بیشتر [۲] و/یا ارتقای فعالیت کاتالیزوری است [۲۰]. از مزایای تکنیک آغشته‌سازی می‌توان به سادگی روش [۲۱]، حفظ مشخصه نانومتری ذرات در دمای پخت پایین، تخفیف مساله عدم تطابق انبساط حرارتی [۲]، توسعه گستره انتخاب مواد الکترود [۲۱]، افزایش سینتیک واکنش سطحی الکترود را ریزساختار ظرفیتر [۲۲]، مانع از رشد دانه فاز مادر [۱۴] و قابلیت کاربرد نانوذرات فلزات گرانبهای [۲۱،۲۳]، اشاره کرد. شایان ذکر است که روش منتخب آغشته‌سازی، تکنیک ارتقاء کارآیی هزینه پایینی [۱۷] است که موانع کاربرد فلزات گرانبهای را به دلیل بارگذاری ناچیز کاتالیست در ساختار الکترود، مرتفع می‌سازد [۲۱].

الکتروشیمیایی سوخت (مثل H_2) محسوب می‌شود [۱] که خواص کاتالیزوری آن برای واکنش اکسیداسیون H_2 به لحاظ نقش ریزساختار آند در انتقال O^{2-} از الکترولیت و انتقال e^- از مواضع واکنش الکترولیت آند به اتصال میانی، حائز اهمیت است. آند، ضمن تخلخل کافی برای انتقال مؤثر گاز و فرآوردهای جنبی (مثل بخار آب) به سمت یا از سوی مواضع الکتروشیمیایی سطحی [۶]، باید هدایت الکترونی خوب و مساحت سطح ویژه بالایی داشته باشد [۱]. در راستای توسعه پیل سوختی اکسید جامد (SOFC) با هدف کاهش دمای کاری [۷] به دمای پایین $400-600^{\circ}C$ (Low Temperature-SOFC) [۸]، جهت جرمان افت کارآیی SOFC از الکترولیت نازک و چگال (Y_2O_3 Stabilized Zirconia) YSZ [۱۰،۹] و جایگزینی $Y_{1-x}Zr_xO_3$ [۱۱،۱۲]، با ماده‌ای با هدایت یونی بالاتر نظری سریا-دوب شده [۲،۳،۵،۱۳]، استفاده می‌شود. بدین ترتیب، با مطرح شدن تلفات پلاریزاسیون الکترودها [۲،۳،۱۴]، نیاز به اصلاح الکترودهای متداول جهت نیل به فعالیت الکتروکاتالیزوری بالا [۹] و مقاومت پلاریزاسیون پایین در دمای LT-SOFC. به عنوان ضرورت تلقی می‌شود. با افزایش نرخ تامین O^{2-} از کاتد (ارتقاء کاتد) و آزادسازی O^{2-} الکترولیت در آند، ماهیت الکتروکاتالیزوری ریزساختار آندهای متداول نیکل/سریا دوب شده با گادلینیم (Ni/GDC) برای LT-SOFC، بیش از پیش حائز اهمیت می‌شود [۱۵]. با توجه به موقع واقعش الکتروشیمیایی در مواضع تلاقي سه فاز هادی O^{2-} و گاز، یا مرز سه فازی (Triple Phase Boundary: TPB) [۶]، به دلیل اینکه سرعت نفوذ سطح <مرزدانه> دانه بلور [۱۱] است، جهت افزایش نرخ واکنش در سطح مشترک گاز/جامد، باید سطح واکنش پذیر کلی، تا حد ممکن افزایش یابد و کاتالیزوری شود [۱]. بدین ترتیب، موضوع شایان توجه در توسعه LT-SOFC ارتقاء کارآیی آند میکروساختار Ni/GDC جهت نیل به فعالیت الکتروکاتالیزوری و پایداری بالاست [۳،۱۴]. کنترل نانومقیاس ریزساختار الکترود [۹] یا نانوساختارسازی، بدلیل وابستگی خواص الکتریکی آند به ترکیب، فرآیند ساخت و ریزساختار حاصله [۳،۱۶]، از جمله راهکارهایی است که جهت ارتقاء کارآیی الکترود میکروساختار ذکر

نانوذرات Pd و ممانعت از آگلومراسیون روی پایه آند Ni/GDC نقش به سزاوی داشته باشد. همچنین، در بررسی تاثیربخشی هزینه Pd مصرفی، مقدار Pd مورد نیاز برای سطح آند به مساحت 1 cm^2 ، تقریباً $1 \mu\text{mol}$ براورده می‌شود. اگر پیل سوتی صرفاً با دانسیت به برق 100 mW/cm^2 کار کند [۲۱]، هزینه فلز Pd مصرفی برای استک (Stack) با توان 1 kW ، تنها $17/10$ دلار (با بهای هر اونس Pd به میزان 500 دلار [۲۵]) خواهد بود. از این‌رو، آغشته‌سازی Pd، روش اقتصادی موثری برای ارتقاء الکتروکاتالیزوری آند متداول Ni/GDC است. بدین ترتیب، در این پژوهش سعی می‌شود تا با هدف کاهش دمای کاری به دمای $400 - 600^\circ\text{C}$ یوسیله جایگزینی الکتروولیت دما بالای YSZ بوسیله GDC، نقش ریزساختاری نانوکاتالیزور Pd بر کارآیی آند Ni/GDC برای واکنش اکسیداسیون H_2 مورد مطالعه قرار گیرد.

۲- فعالیت‌های تجربی

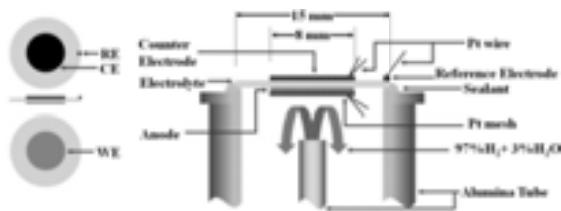
پودر GDC20 ($\text{Ce}_{0.8}\text{Gd}_{0.2}\text{O}_{2-\delta}$)، از واکنش حالت جامد پودرهای CeO_2 و Gd_2O_3 (Kojundo Chemical)، $99/9\%$ ، ژاپن در 1200°C و ۲ ساعت تهیه شد.

از روش ریخته‌گری نواری پایه-آلی، برای تهیه زیرلایه الکتروولیت استفاده شد. سینترینگ نوارهای خام، در 400°C ۱۰ و ۵ ساعت در هوا صورت گرفت تا الکتروولیت GDC20 با دانسیتی بالاتر از 93% دانسیتی تئوری، به قطر 15 میلی‌متر و ضخامت $~300 - 400$ میکرومتر بدست آید. پودر کامپوزیت NiO/GDC20، از آسیاب ماهواره‌ای (Kojundo Chemical)، $99/97\%$ ، مخلوط پودرهای NiO ژاپن و GDC20 (با کسر وزنی $40/60$) در اتانول، با سرعت 500 rpm برای ۲ ساعت، در محفظه زیرکونیایی با گلوله‌های زیرکونیا به قطر 1 میلی‌متر تهیه شد. پیش ماده $\text{NiO}_{0.6}\text{-GDC}_{0.4}$ برای شکل‌دهی آند نیم پیل پایه الکتروولیت LT-SOFC استفاده شد. خمیر پودر کامپوزیت و محلول آلی چاپ، پس از همگن‌سازی، به روش چاپ تئوری روی مرکز الکتروولیت اعمال شد. سینتر در 1350°C به مدت ۲ ساعت در هوا، جهت نیل به آند کامپوزیت متخلخل (NiO/GDC20) NiO/GDC20)، به

جستجوی منابع مطالعاتی نشان می‌دهد که در ده تا پانزده سال گذشته، از فلزات گرانبهای Pt، Rd، Ru و Pd، به عنوان افزودنی ($1-5\% \text{ wt.}$) در ساخت الکترودهای دما بالای SOFC جهت ارتقاء کارآیی آند یا کاتد و افزایش دانسیتی برق، استفاده شده است [۳]. کاربرد Pt، به منزله الکتروکاتالیست معمول پیلهای سوتی (پلیمری) دما پایین (LT-FC) [۲۴]، بدليل هزینه فوق العاده بالا [۲۵] و محدودیت تامین جهانی نسبت به Pd، محدود است [۲۶]. Ru نیز به عنوان کاتالیزور تولید هیدروژن بکار رفته است [۲۷]. اما با توجه به هدف کاربرد سوتی هیدروژن برای آند در پژوهش حاضر، در بین کاتالیزورهای فلزی، Pd، آند در پژوهش حاضر، تمایل فوق العاده شدیدی به جذب بطور منحصر بفردی، تمایل فوق العاده شدیدی به تفکیکی مولکول H_2 (بدون یا با سد انرژی اکتیواسیون کم) نشان می‌دهد و به همین خاطر، به عنوان کاتالیست تسهیل جذب و واجذب هیدروژن بکار می‌رود که بخشی از هیدروژن، درون خود کاتالیست، به صورت PdH_x ($x=0.60-0.70$) ذخیره می‌شود [۲۶]. نتایج کاربرد فلز Pd روی پایه CeO_2 برای بهبود فعالیت کاتالیزوری، حاکی است که فعالیت اکسیداسیون نسبت به CeO_2 یا هر اکسید دیگری به مراتب بسیار بالاتر است [۲۸]. نتایج آغشته‌سازی نانوذرات Pd در آند Ni/GDC ملحق به الکتروولیت YSZ در دمای کاری بالا ($650-900^\circ\text{C}$ ، نشان می‌دهد که مقاومت پلاریزاسیون الکترود کاهش می‌یابد [۲۹] اما مساله رشد دانه و آگلومerasیون شدید نانوذرات Pd، به قوت خود باقی می‌ماند [۳۰]. نظر به اینکه نانوذرات فلزی برای کاربردهای کاتالیزوری، واکنش‌پذیری وابسته به اندازه (اندازه کوچکتر، فعالیت بیشتر) نشان می‌دهند [۳۱]، با افزایش دما و کاهش کشش سطحی فلز [۳۲]، تمایل به سینترینگ و رشد دانه [۱۴] طی عملکرد پیل (به دلیل بالا بودن انرژی سطحی نانوفلز)، اجتناب‌نپذیر می‌شود [۲۲]. اگر در دمای کاری آند، نرخ تبخیر کاتالیزور فلزی بالا باشد، تبخیر نانوذرات فلزی، مساله مهمی به شمار می‌رود [۲۱]. شواهد تجربی، حاکی از پایداری حرارتی پایین نانوذرات فلزی نظیر Ni، Pd و Pt، در دمای $800-200^\circ\text{C}$ است [۱۴]. از محاسبه فشار جزئی فلز کاتالیزور Pd در محیط احیاء [۲۱]، به نظر می‌رسد که کاهش دمای کاری، می‌تواند در حفظ ابعادی

نانوذرات، با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری JEOL JEM-2100F(UHR) .HR-TEM) (با ولتاژ ۲۰۰ kV در حالت زمینه روشن (Bright Field: BF ارزیابی شد.

آماده سازی نمونه به روش تبخیر سوسپانسیون روی فیلم فوق العاده نازک کربن/سوراخ دار ملحق به پایه مسی (Ultrathin Carbon/Holey Support on Copper Grid) انجام شد. مطالعه ترکیب شیمیایی پالادیم در آند، توسط طیف‌سنجی فتوکلترون (ESCALAB 220-IXL XPS) انجام شد. پرتو اشعه ایکس $MgK\alpha$ ($h\nu = 1253/6$ eV) و فشار 10^{-9} torr جهت نیل به اطلاعات تکمیل شست شد.



شكل ١: الگوی سه الکتروودی نیم پیل پایه الکتروولیت متران برای اندازه‌گیری الکتروشیمیایی.

٣- نتایج و پژوهش

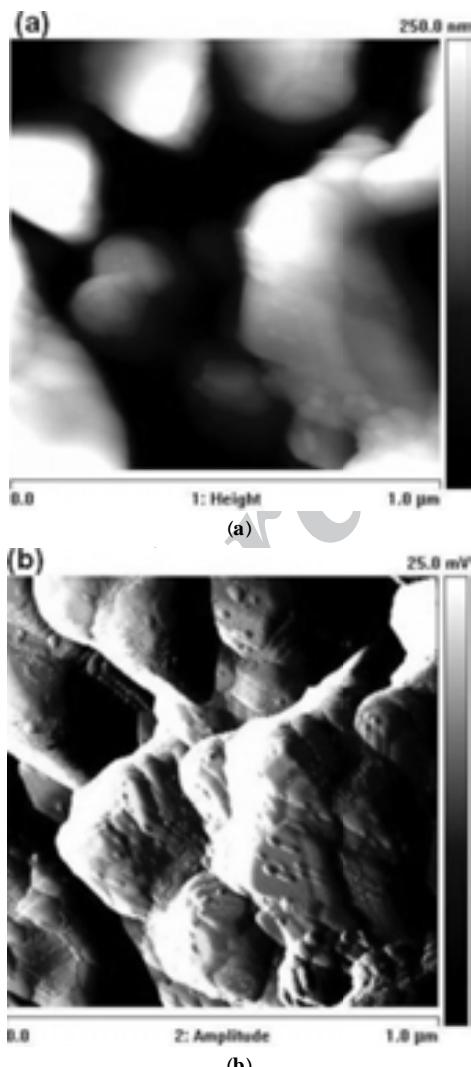
۱-۳- ریز ساختار آندهای آغشته سازی شده

با اعمال تمامی تمهیدات لازم جهت شناسایی فازی
نانوذرات حاوی پالادیم توسط تکنیک مرسوم پراش اشعه
XRD (XRD)، نتیجه حاکی از عدم کارایی تکنیک
متداول در بررسی فرآیند آغشته‌سازی نمونه‌ها است، این
موضوع، به محتوی بسیار ناچیز نانوذرات بارگذاری شده
روی پایه‌های آند، به عنوان مثال حدود ۱۵٪ در نمونه
D-8 با بیشترین بارگذاری، مرتبط است. از این‌رو،
شناسایی ترکیب نانوذرات آغشته‌سازی شده در مراحل این
تحقيق، بوسیله آنالیز EDS در میکروسکوپ‌های الکترونی
و نیز XPS ارائه می‌شود. بررسی XPS طیف ۳d
کامپوزیت NiO/GDC پس از انمام فرآیند آغشته‌سازی در
نمونه D-8 (شکل ۲)، دو پیک متقابران ۳۴۱/۴ و ۳۴۶/۱
الکترون ولت را نشان می‌دهد که در توافق بسیار مناسبی
با پیک‌های مشخصه ۳d_{3/2} (۳۴۲/۲) الکترون ولت) و
Pd ۳d_{5/2} (۳۳۶/۹) Pd ۳d_{5/2} (۳۳۶/۹) الکترون ولت) ترکیب شیمیایی،

مساحت ۰/۵ سانتیمتر مربع و ضخامت ۱۵ ~ میکرومتر
انجام شد.

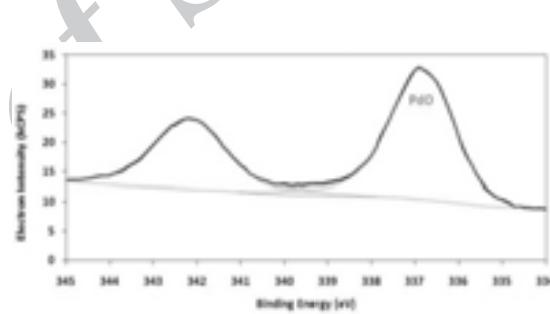
از محلول آبی /۱۰ مولار کلرید پالادیم (PdCl_2) و مولار نانوساختارسازی آند Ni/GDC به روش آغشته‌سازی استفاده شد. قطره‌ای از محلول روی سطح کامپوزیت قرار داده شد. پس از نفوذ در حفرات، مازاد NiO/GDC محلول، زدوده شد. نمونه در 600°C ۱ ساعت تکلیس شد. فرآیند آغشته‌سازی، برای افزایش بارگذاری، تکرار شد. میزان بارگذاری، با توزین نمونه، قبل و بعد از عملیات حرارتی آغشته‌سازی، با دقت ۰/۰۱ میلی‌گرم تعیین شد. الکترودهای NiO/GDC با صفر، ۱، ۴ و ۸ بار آغشته‌سازی، به ترتیب مؤید صفر، $0/03$ ، $0/13$ و $0/26 \text{ mg/cm}^2$ بارگذاری (برای سهولت با نام D-0، D-1، D-4 و D-8)، انتخاب شدند. از نیم پیل پایه الکتروولیت متقارن، با الگوی سه الکتروودی آند (Working Electrode: WE)، الکتروود کاتد (Counter Electrode: CE) و الکتروود مرجع (Reference Electrode)، برای اندازه‌گیری امپدانس الکتروشیمیایی در شرایط مدار باز در 600°C ، تحت هیدروژن مرطوب در آند و هوای آزاد در کاتد استفاده شد (شکل ۱)، قبل از شروع اندازه‌گیری، احیاء اکسید نیکل، بطور درجا (In-situ) در 600°C در ۱ h انجام گرفت. کیفیت آغشته‌سازی نانوذرات حاصل از اولین بارگذاری در آند، توسط میکروسکوپ نیرو اتمی (AFM) مدل سنجیده (VEECO Dimension 3100+Nanoscope V7) شد. تصاویر در حالت Tapping با سرعت سوزن $1/99 \mu\text{m/s}$ و با نرخ روبش $0/996 \text{ Hz}$ در اندازه روبش $1 \times 1 \mu\text{m}^2$ ثبت شد. برای بررسی مورفولوژی، توزیع اندازه نانوذرات و کیفیت فرآیند آغشته‌سازی در ریزساختار آند، پس از احیاء (با پسوند نامگذاری R-) و بعد از تست آند (با پسوند نامگذاری AT-)، از میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل (Philips XL30S FEG, SEM)، ساخت کشور هلند استفاده شد. میانگین اندازه نانوذرات Digital Micrograph شده، به کمک نرمافزار (از دست کم ۱۰۰ ذره) و میزان تخلخل به کمک نرمافزار تعیین شد. آنالیز عنصری بوسیله EDS ImageJ1.45s اشعة ایکس ارزیابی (Energy Dispersive Spectroscopy) شد. مورفولوژی، توزیع، تکثیر شیمیایی، و بلورینگ،

در حالت تصویر آند است. تصویر دامنه، با نمایش کیفیت انحراف سوزن در مواجهه با نقشه نمونه در بعد Z معادل با نقشه‌ای از شیب نمونه است و اغلب اوقات، شکل نمونه را به سهولت بیشتری بویژه در لبه‌ها، ذرات و حفرات نشان می‌دهد. نتایج AFM نشانگر توزیع مجرای نانوذرات آغشته‌سازی شده در اندازه ۴-۲۸ نانومتر روی تمامی سطح پایه آند میکروساختار Ni/GDC با میانگین اندازه ذرات حدود ۰/۵-۰/۲۵ میکرومتر است. مناطق تیره در میکروساختار پایه آند، حفره‌های ۰/۷-۰/۱۵ میکرومتری بجای مانده از سوختن محلول آلی چاپ توری را نشان می‌دهد، این حفرات برای تامین پیوسته سوخت هیدروژن و خروج آب از مواضع واکنش آند طی عملکرد پیل مفید است.



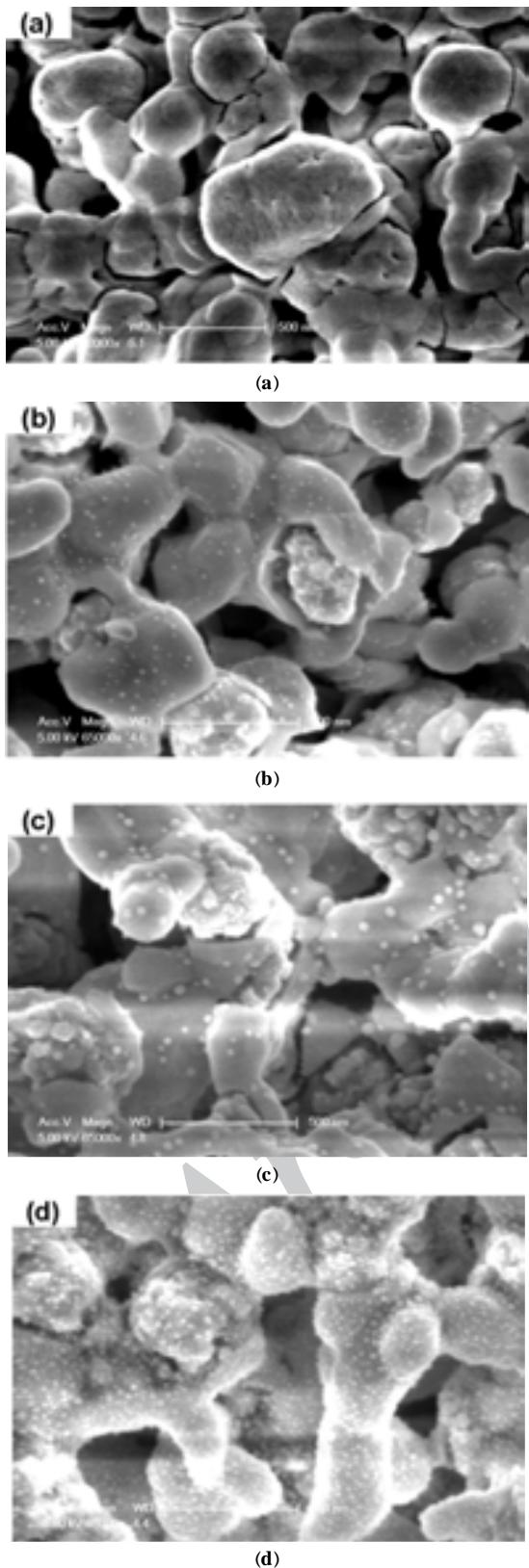
شکل ۳: تصویر AFM آند D-1-R (a) ارتفاع و (b) دامنه.

برگرفته از بانک اطلاعاتی XPS موسسه ملی استانداردها و تکنولوژی [۳۳] است. لازم بذکر است علیرغم مطالعاتی مبسوط، راجع به مشکل خروج کلرید از سطح کاتالیست پس از آغشته‌سازی با PdCl_2 [۳۴] (یعنی PdCl_2 در HCl) که مسبب تاثیر منفی بر فعالیت و گزینش پذیری کاتالیست می‌شود [۳۵]، پیک کلر باقیمانده از محلول پیش ماده کلرید پالادیم روی سطح در پایان عملیات آغشته‌سازی (شکل ۲) دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد که در صورت وجود کلر، میزان ترکیب حاوی کلر، زیر حد شناسایی سیستم آنالیزی XPS [۳۶] بوده است. از این‌رو، بر اساس موقعیت پیک‌ها [۳۳] در شکل ۲ و حالت پایدار ترمودینامیکی اکسید پالادیم در دماهای ۸۸۰-۲۰۰ °C [۳۷]، می‌توان گفت که PdO تنها ترکیب حاوی پالادیم است که از فرآیند آغشته‌سازی محلول کلرید پالادیم (قبل از احیاء) حاصل می‌شود.



شکل ۲: طیف ۳d کامپوزیت D-8 پس از اتمام عملیات آغشته‌سازی.

از آنجا که تکنیک‌های میکروسکوپ پروفیل روبیشی (Scanning Probe Microscopy: SPM)، رویکرد خاصی را برای بازبینی سطح الکترود SOFC با قدرت تفکیک نانومتری مهیا می‌کنند [۳۸] و هم در زیرمجموعه این تکنیک‌ها، در زمانیکه میکروسکوپ الکترونی، طرح تجسمی یا تصویری دو بعدی از نمونه فراهم می‌نماید، یک پروفیل سه بعدی واقعی از سطح آند را به نمایش در می‌آورد [۳۹]. بررسی AFM آند Ni/GDC پس از یکبار آغشته‌سازی (D-1-R) به منظور مطالعه کیفیت توزیع نانوذرات آغشته‌سازی شده و اندازه دانه، بطور نمونه انجام شد که نتیجه آن در شکل ۳ ارائه شده است. شکل ۳a، ارتفاع (Height) یا نقشه نگاری (Topography) دو بعدی و شکل ۳b، دامنه (Amplitude) یا انحراف/اختلاف ارتفاع و شکل ۳c، دامنه (Amplitude) یا انحراف/اختلاف ارتفاع

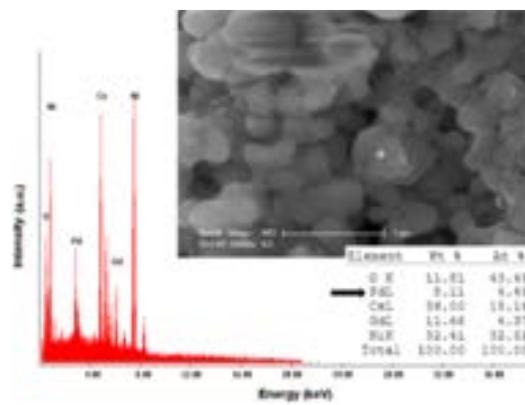


شکل ۴: تصویر SEM آندهای D-0-R (a) و D-8-R (d) و D-4-R (c) و D-1-R (b)

عمل احیاء NiO به Ni در هیدروژن، موجب انقباض حجمی حدود ۴۰٪ [۴۰، ۴۱] و بجای ماندن نانوتخلخل می‌شود. این واکنش خودکاتالیزوری، در سطح مشترک NiO/GDC شروع می‌شود و به سمت مرکز دانه‌های NiO پیش می‌رود [۴۲]. شکل ۴، تصویر SEM کامپوزیت‌های بدون/با آغشته‌سازی را پس از احیاء در H₂ جهت تشکیل آند سرمت Ni/GDC (با نماد R-)، در بزرگنمایی یکسان جهت مقایسه بصری نشان می‌دهد. در شکل ۴a، فضاهای خالی حول و درون ذرات که در اثر احیاء هیدروژنی NiO به Ni ایجاد شده‌اند، به وضوح دیده می‌شوند. میانگین اندازه ذرات در آند سرمت پایه Ni/GDC پس از احیاء (D-0-R)، حدود ۳۰۰ نانومتر و میزان تخلخل آن ۴۳ درصد است. عدم رؤیت سطوح تمیز ذرات آند سرمت پایه (شکل ۴a) در توالی فرآیند آغشته‌سازی در شکل‌های ۴b-d مؤید پوشش یکنواخت سطوح توسط نانوذرات آغشته‌سازی با مورفولوژی کروی یا شبیه کروی است. میانگین اندازه نانوذرات آغشته‌سازی شده روی آندهای D-4-R و D-8-R به ترتیب ۱۵، ۳۰ و ۲۷ نانومتر است. گستره توزیع اندازه نانوذرات در بارگذاری کم، باریک و در بارگذاری بالاتر، پهن است. شیوه نانوساختارسازی در بارگذاری کم، به صورت توزیع مجرای نانوذرات است (شکل ۴b) که این امر به زاویه تماس بالای سطح و ضعف ترشوندگی [۴۳] نسبت داده می‌شود. با افزایش بارگذاری، تجمع و افزایش اندازه نانوذرات (شکل ۴c) منجر به افزایش ناهمواری سطحی می‌شود. با پوشش فراینده سطح، ناهمواری سطحی کاهش [۴۴] و ترشوندگی سطح، بهبود می‌یابد [۴۳] بطوریکه پس از هشت مرتبه بارگذاری (شکل ۴d)، به دلیل فراوانی ذرات، نانوشکه پیوسته‌ای از نانوذرات روی تمامی سطح آند احداث می‌شود، این در حالی است که میزان تخلخل الزامی آند، تغییر چندانی نمی‌کند. آنالیز EDS (موقع علامت‌گذاری شده در نانوشکه) آند D-8-R در شکل ۵، حضور پالادیم را در ترکیب نانوذرات حاصل از احیاء تایید می‌نماید. لازم به ذکر است که به علت محدودیت قدرت شناسایی EDS، تنها در آند D-8-R ردیابی حضور ترکیب پالادیمی میسر است.

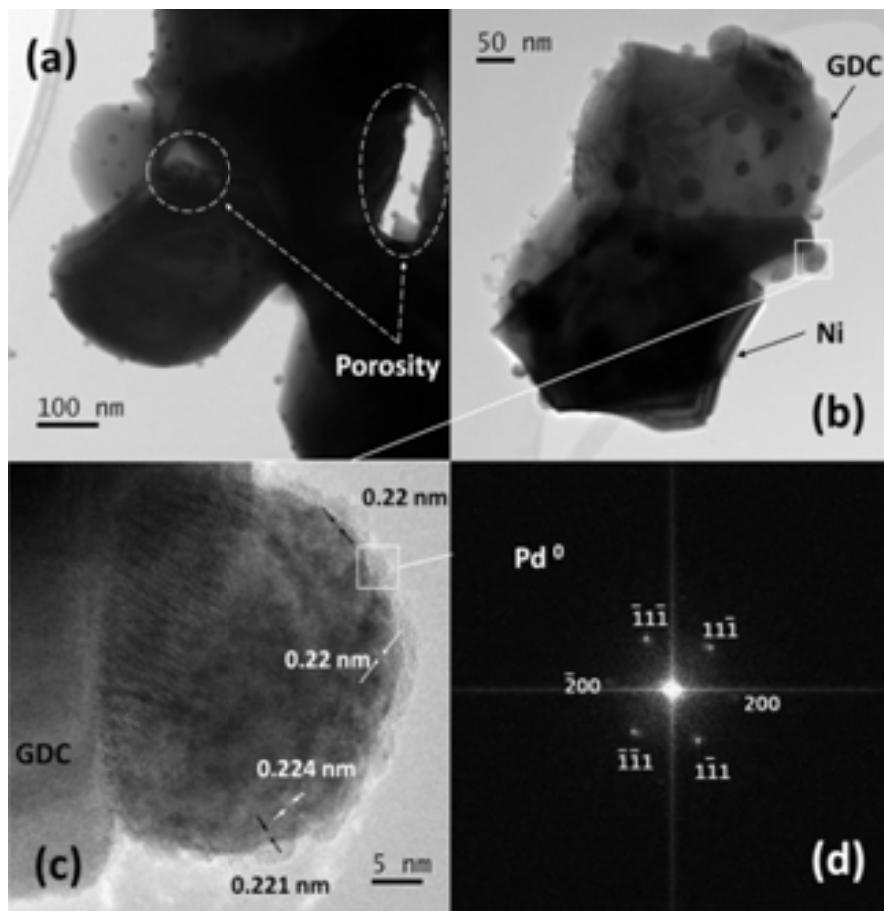
این نانوذرات (22 nm)، مشخصه ویژه صفحات {111} پالادیم فلزی (Pd^0) با شبکه بلوری مکعبی مرکز سطحی (Full Face Centered Cubic: FCC) است. شایان ذکر است که صفحه (111) در شبکه FCC، به عنوان صفحه‌ای پایدار با تراکم اتمی بالا محسوب می‌شود.

تصویر FFT (Fast Fourier Transform) یکی از نانوذرات مشخص شده در شکل ۶c نیز، مؤید انعکاس‌های Pd^0 در محور منطقه <011> شبکه FCC است (شکل ۶d). با استفاده از پراش نگاره (Diffractogram) شکل ۶d می‌توان انعکاس‌های صفحات {111} و {200} متعلق به شبکه FCC پالادیم فلزی را همانطور که در شکل مشخص شده است، اندیس‌گذاری کرد. با توجه به نتایج فوق می‌توان گفت که ترکیب توده (bulk) نانوذرات حاوی پالادیم حاصل از عمل احیاء هیدروژنی، بطور مطلق Pd^0 فلزی است. بررسی ترکیب سطحی نانوشبكه آغشته‌سازی شده پالادیمی در آند سرمت D-8-R توسط XPS (شکل ۷) در قیاس با شکل ۲، حاکی از شبکه متقاضن پیک‌ها و تغییر مکان طیف 3d به سمت انرژی پیوندی پایین‌تر است. بعلاوه، اثر محیط هیدروژن، منجر به کاهش قابل ملاحظه شدت پیک Pd 3d می‌شود به گونه‌ای که احتمالاً به دلیل مقدار بسیار ناچیز PdO در طیف و مستور شدگی (Screening) شدید توسط تجمع پالادیم‌های فلزی [۳۷]، عملاً هیچ ترکیب اکسیدی تشخیص داده نمی‌شود. لازم بذکر است وجود نوسان‌ها روی حالت 3d $3/2$ ($340/0.3$ و $340/0.43$) و 3d $5/2$ (الکترون ولت) را نمی‌توان به دلیل فقدان ظهور شانه روی سمت چپ/راست حالت اصلی Pd 3d $5/2$ ، به پیک خاصی نسبت داد. در نتیجه، انرژی پیوندی حدود $340/0.30$ الکترون ولت و نیز $340/0.3$ الکترون ولت، به ترتیب به حالت 3d $3/2$ ($335/1$ الکترون ولت) و 3d $5/2$ ($335/0.4$ الکترون ولت) مشخصه ترکیب Pd^0 فلزی [۳۳]، تشخیص داده می‌شود. بنابراین، بر اساس نتایج بررسی نانوذرات پالادیمی در حجم (توضیح TEM) و در سطح (توضیح XPS)، عمل احیاء یک ساعته در 600°C ، موجب احیاء کامل نانوذرات PdO به Pd^0 فلزی می‌شود در حالیکه در عمل احیاء در 700°C درجه سانتیگراد، گزارشی از احیاء ناقص PdO (به میزان قابل توجه 27%) بدلیل نقش تاخیر انداز ذرات



شکل ۵: آنالیز SEM-EDS آند D-8-R

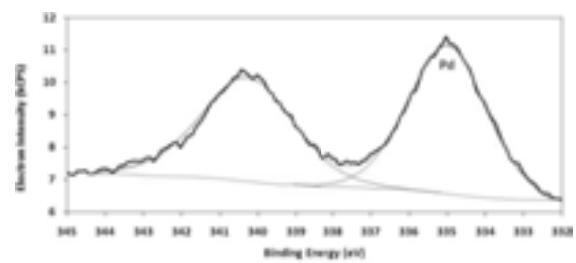
شکل ۶، تصویر TEM-BF آند D-1-R را بطور نمونه ارائه می‌نماید. در تصویرسازی TEM در بزرگنمایی پایین مانند شکل‌های ۶a-b، بدلیل مکانیزم تباين پراشی (Diffraction Contrast)، نانوذرات حاوی پالادیم روی سطح دانه‌های آند Ni/GDC با توزیعی یکنواخت، قابل مشاهده است. مورفولوژی نانوذرات، مشابه تصاویر SEM بصورت کروی یا شبکه کروی است. مقدار میانگین اندازه نانوذرات در بررسی بیش از 100 نانوذره، به عدد $14/4$ نانومتر می‌رسد که تایید کننده میانگین اندازه نانوذرات (۱۵ نانومتر) است. در شکل ۶a، تخلخل‌های SEM ریزساختار، به صورت مناطق مشخص شده و در شکل ۶b هم مورفولوژی نانوذرات روی آگلومرهای از ذرات ریزساختار آند Ni/GDC به وضوح دیده می‌شود. به دلیل تباين پراشی و فازی (Phase Contrast)، می‌توان ارزیابی مناسبی از توزیع دانه‌های متخلخل Ni (با کنتراست تیره‌تر) و دانه‌های غیرمتخلخل GDC (با کنتراست روشن‌تر) در ریزساختار، همانگونه که در شکل ۶b نشان داده شده است، دارد. در حیطه HR-TEM، به کمک مکانیزم تباين فازی (Phase Contrast)، می‌توان به قدرت تفکیک مناسبی (تا حدود 0.2 nm) جهت مطالعه جزئیات تصویر و شناسایی شبکه بلوری دست یافت. بررسی HR-TEM نانوذرات در شکل ۶c با این رویکرد (به عنوان مثال یکی از نانوذرات در شکل ۶b مشخص شده است)، نشان می‌دهد که هر نانوذره با مورفولوژی شبکه کروی، مشتشکل از تعداد زیادی نانوذره متبلور کوچکتر است که در راستای ترجیه‌ی خاصی رشد یافته است. همانگونه که در شکل ۶c برچسب‌گذاری شده است، فواصل شبکه‌ای در



شکل ۶: (a) تصویر TEM آند D-R، (b) تصویر TEM آگلومرهای از آند D-1-R، (c) تصویر HR-TEM آند D-1-R، (d) تصویر FFT نانوذره مشخص شده در شکل b و نانوذره مشخص شده در شکل c.

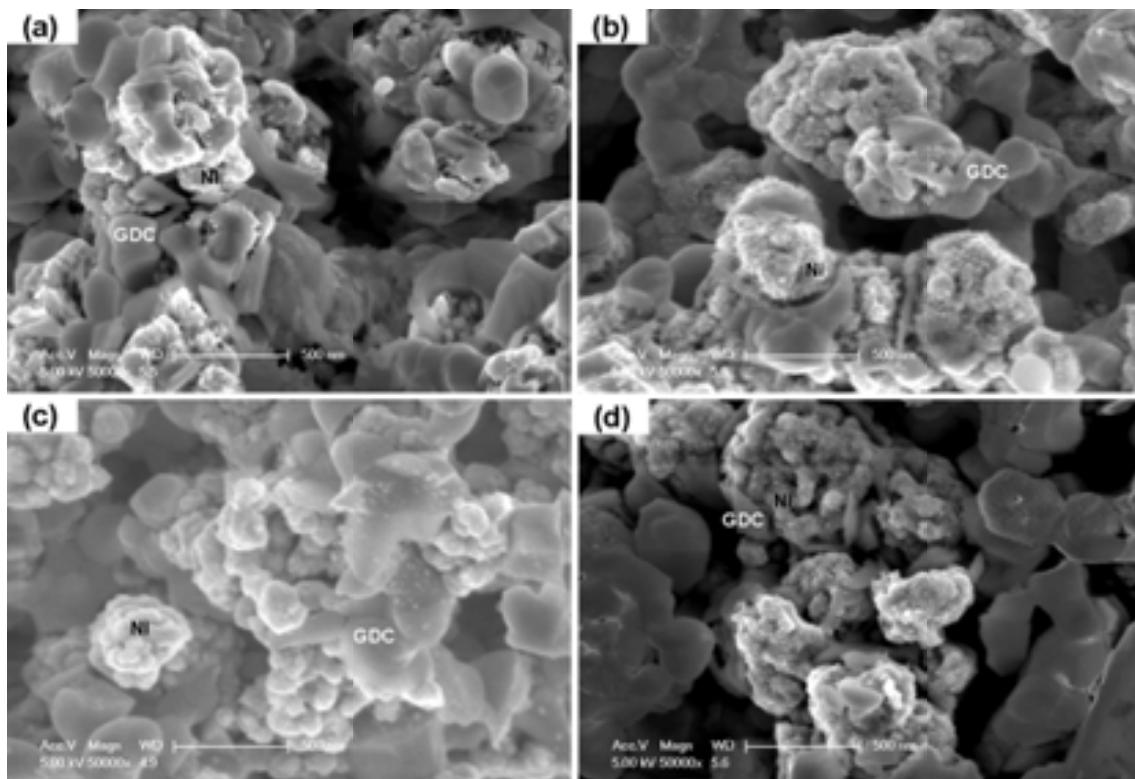
این افزایش، به نقش ممانعت کننده سینترینگ ذرات Ni (حاصل از احیاء)، در ورود/خروج گاز H_2 به سطح مشترک Ni/NiO [۴۵] و رشد دانه نیکل، نسبت داده می‌شود. بعد از تست پیل، ذرات GDC، به دلیل مشخصه عدم فراریت بالک تا $250^\circ C$ [۴۶] و خروج دیفوزیونی نیکل تبلور یافته از دانه‌های GDC [۴۷]، به وضوح از ذرات Ni قابل تمایز هستند. میانگین اندازه ذرات GDC و Ni در آند پایه، به ترتیب ۲۱۶ و ۳۱۶ نانومتر است (شکل ۸a). مقایسه ریزساختار سطح شکست آندهای بدون/با آغشته‌سازی نیز مؤید قابلیت تشخیص مناسب آگلومرهای Ni از توده‌های بسیار ریزتر پالادیم آغشته‌سازی شده است. میانگین اندازه نانوذرات روی آند D-1-AT (شکل ۸b)، D-4-AT (شکل ۸c) و D-8-AT (شکل ۸d)، به ترتیب ۲۷، ۱۹ و ۲۰/۵ نانومتر است. ارزیابی اندازه نانوذرات (نسبت به قبل از تست امپدانس) دلالتی بر این دارد که در بارگذاری کم

نیکل [۳۰]، به چشم می‌خورد. شکل ۸، تصویر SEM ریزساختار آندهای Ni/GDC را پس از حدود هشت ساعت قرارگیری در معرض تست امپدانس الکتروشیمیایی در دماهای $400-600^\circ C$ (با نماد AT) در بزرگنمایی مشابه شکل ۴ جهت مقایسه نشان می‌دهد.



شکل ۷: طیف Pd 3d آند سرمت D-8-R پس از احیاء در هیدروژن.

تخلخل آند پایه D-0-AT، با افزایش جزئی نسبت به قبل از تست (۴۳ درصد)، به ۴۴/۵ درصد می‌رسد (شکل ۸a).



شکل ۸: تصاویر SEM آندهای (a: D-0-AT (b: D-4-AT (c: D-1-AT (d: D-8-AT

D-8-AT را به همراه آنالیز پروفیل پوشش سطحی در راستای خطوط مشخص شده A تا E نشان می‌دهد.



شکل ۹: تصویر HR-SEM آند D-8-AT با پروفیل پوشش روی: (A,B) دانه‌های GDC، (C,D) مقطع-شکست دانه GDC و (E) آگلومره‌های Ni

پروفیل خطهای A و B، پوشش نانوذرات آغشته‌سازی شده روی دانه‌های GDC، پروفیل خطهای C و D، پوشش روی مقطع شکست دانه‌های GDC و پروفیل خط E، پوشش نانوذرات آغشته‌سازی شده روی آگلومره‌های Ni است. مقایسه پروفیل خطوط A، B، C و D، نشان می‌دهد که پوشش نانوذرات Pd روی Ni، از آگلومره‌های بزرگتری

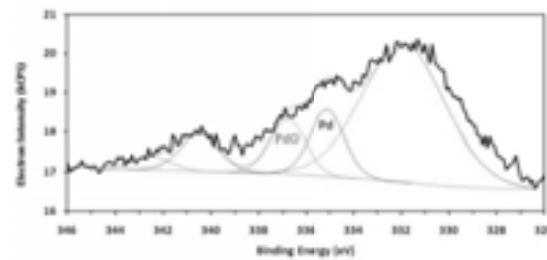
(شکل ۸b)، به دلیل زاویه تماس بالای سطوح [۴۳] (ترشوندگی کم)، تمایل ذرات به تجمع و آگلومره‌سازی، زیاد است اما با افزایش بارگذاری، روند معکوسی (حتی با کاهش میانگین اندازه ذرات) پدیدار می‌شود (شکل ۸d). به نظر می‌رسد فشار جزئی کاتالیست Pd در محیط H_2 عامل کلیدی برای پایداری طولانی مدت و تمایل کمتر نانوذرات به آگلومره‌سازی باشد [۲۱]. داده‌های ترمودینامیکی در محیط H_2 نشان می‌دهد که فشار جزئی فلز Pd در دماهای تست $400-600^{\circ}C$ ، در محدوده $10^{-11}-10^{-17} Pa$ تغییر می‌یابد [۴۸] که به مراتب پایین تر از $10^{-5}-10^{-1} Pa$ مربوط به فشار جزئی فلز Pd [۴۸] در دماهای کاری $950-650 Pa$ در مطالعه SOFC دما بالا است. به همین دلیل هم، تبخیر Pd در دمای کاری بالاتر SOFC، امکان پایداری دراز مدت نانوذرات Pd را سلب می‌نمود و منجر به آگلومره‌های بزرگی حتی تا ۱۰۰ نانومتر می‌شد [۳۰]، در حالیکه در کار حاضر، حداقل اندازه آگلومره‌ها به کمتر از نصف این مقدار، یعنی به ۴۰ نانومتر می‌رسد. شکل ۹، HR-SEM سطح شکست آند

صورت PdH_x ، شرکت می‌کند [۲۶]، حضور Pd^0 فلزی در نانوشبکه آغشته‌سازی شده، مؤید انتقال گونه فعال H است. ظهر PdO هم در محیط احیایی آند، شاهدی مبنی بر نقش به سزای پالادیم در تسهیل فرآیند دیفوژیون اکسیژن و انتقال یون‌های O^{2-} است. بدین ترتیب، بر اساس مطالعات ریزاساختاری فوق می‌توان استنتاج نمود که نانوذرات Pd آغشته‌سازی شده روی آند Ni/GDC برای واکنش اکسیداسیون H_2 تحت عملکرد LT-SOFC، نه تنها در انتقال گونه فعال H شرکت می‌کنند، بلکه در انتقال یون‌های O^{2-} نیز نقش به سزایی دارند و این تحقیق، خود شاهدی برای تایید Spill-Over هیدروژن و اکسیژن روی پالادیم، تحت عملکرد LT-SOFC است.

۲-۳- کارایی آندهای آغشته‌سازی شده

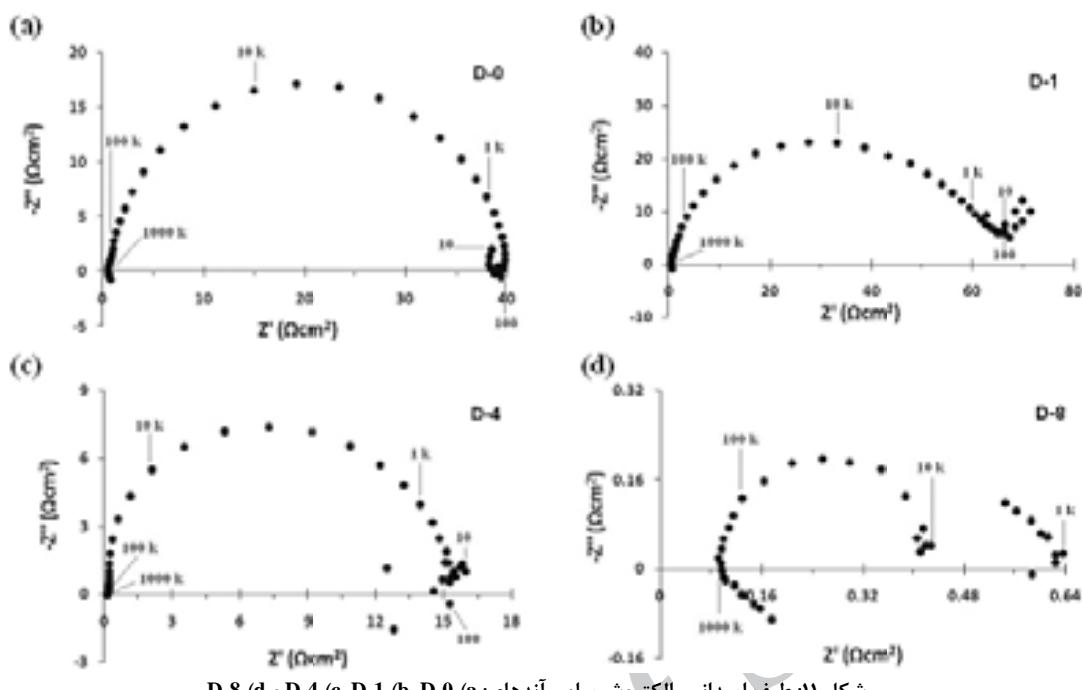
مقاومت پلاریزاسیون آندی، R_a ، معیاری از کارایی آند است که از داده‌های امپدانس الکتروشیمیایی حاصل می‌شود. شکل ۱۱a-d، به منظور مقایسه اجمالی، رسم نایکوئیست Nyquist (رفtar امپدانس آندهای Ni/GDC بدون با آغشته‌سازی را در نیم پیل پایه الکتروولیت برای اکسیداسیون H_2 در دمای $500^{\circ}C$ نشان می‌دهد. مقدار R_a ، از تفاضل مقادیر تقاطع فرکانس پایین و بالای طیف امپدانس با محور حقیقی تعیین می‌شود. مقدار R_a ، برای آندهای D-0، D-1، D-4 و D-8 به ترتیب، $37/96 \Omega.cm^2$ ، $65/85 \Omega.cm^2$ ، $12/31 \Omega.cm^2$ و $0/38 \Omega.cm^2$ می‌باشند. افزایش R_a پس از یکبار آغشته‌سازی (در قیاس شکل‌های ۱۱a-b) به توزیع مجزای نانوذرات پالادیم روی ریزاسختار آند و رشد دانه نسبی نانوذرات طی تست پیل (از ۱۵ نانومتر به ۱۹ نانومتر) مبتنی بر نتایج ریزاساختاری ارائه شده در مبحث ۱-۳، نسبت داده می‌شود. مقدار R_a ، با افزایش بارگذاری کاهش می‌یابد زیرا روند رشد دانه نانوذرات متوقف و حتی معکوس می‌شود، بطور مثال، در آند سرمت D-4 (شکل ۱۱c). کاهش حدود 0.67% نسبت به آند بدون آغشته‌سازی (شکل ۱۱a) دیده می‌شود. این در حالی است که میانگین اندازه نانوذرات در طول تست آند از 30 نانومتر به 27 نانومتر کاهش می‌یابد. مطابق شکل ۱۱d، با هشت بار آغشته‌سازی پالادیم، کاهش تقریباً 100% در R_a بدليل کاهش اندازه نانوذرات از

تشکیل شده است. در حالیکه پوشش ریزتری از نانوذرات GDC بدون یا با آگلومره‌سازی کمتر، روی سطوح ذرات دیده می‌شود. مشاهدات بر این نکته تأکید دارد که بهم پیوستگی و رشد نانوذرات (نانوآگلومره‌ها) در آند سرمت Ni/GDC، بیشتر روی نواحی متخلخل Ni ایجاد می‌شود. است؛ این امر به سهولت ترشوندگی نانوذرات Pd فلزی روی Ni نسبت داده می‌شود. شکل ۱۰، طیف XPS Pd 3d روی Ni آند D-8-AT را با پهن‌شدگی طیف نشان می‌دهد.



شکل ۱۰: طیف Pd 3d آند سرمت پس از تست امپدانس الکتروشیمیایی.

پس از عملیات تفکیک‌پذیری (Deconvolution)، یک بزرگی در سمت انرژی پایین مشاهده می‌شود که مؤید کربن (به احتمال زیاد ناشی از چسب کربن ملحاق به نمونه) است. طیف XPS شکل ۱۰، می‌تواند به دو زوج Pd^0 (اصلی Pd 3d با انرژی پیوندی Doublet) و $Pd^{5/2}$ (کترنون ولت $335/1$ و کترنون ولت $336/77$) تقسیم شود که به ترتیب مربوط به حالت پالادیم فلزی (به احتمال کمتر، زوج اکسایش-کاهش PdO_x/Pd) و PdO [۳۳] است. زیرا زوج Pd 3d اکسایش-کاهش PdO ، با انرژی پیوندی $335/1$ کترنون ولت $340/40$ (کترنون ولت Pd 3d5/2) در اتمسفرهای اکسیژنی گزارش شده است تا در محیط هیدروژن [۳۳]. محاسبه مساحت سطح زیر پیک نشان می‌دهد که Pd^0 فلزی، سهم $55/0.3$ درصدی و PdO ، سهم $44/97$ درصدی از طیف Pd 3d را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین، آنالیز سطحی نانوساختار آغشته‌سازی شده پس از تست امپدانس تا مقیاس 12 نانومتر مشخص می‌کند که حدود 45 درصد از نانوشبکه Pd^0 فلزی، به PdO تبدیل شده است. از آنجاییکه کاتالیست Pd^0 فلزی، از طریق مکانیزم Spill-Over، در جذب هیدروژن (به



شکل ۱۱: طیف امپدانس الکتروشیمیایی آندهای: (a) D-0 (b) D-1 (c) D-4 (d) D-8

روی سطح آند Ni/GDC، مسئول انتقال گونه‌های فعال (Spill-Over) هیدروژن و اکسیژن تحت عملکرد LT-SOFC و منشأ ارتقاء چشمگیر کارآیی آند است.

سپاسگزاری

بخشی از این تحقیق، تحت حمایت مالی POSTECH انجام شد. بدینوسیله نویسندهان، از S.H. Oh آزمایشگاه G.Y. Shin، AEMN در آزمایشگاه S.J. Won مدیر اسبق آزمایشگاه XPS و اعضای آزمایشگاه ECERA به لحاظ همکاری فراوان و از علی احسانی، به دلیل بحث‌های مفید، کمال تشکر را دارند.

مراجع

- [1] A.J. Moulson, J.M. Herbert, "Electroceramics: Materials, Properties, Applications", Wiley and Sons Ltd, England, 2003.
- [2] Z. Jiang, C. Xia, F. Chen, *Electrochimica Acta*, **55**, 2010, 3595.
- [3] S.P. Jiang, S.H. Chan, *Journal of Materials Science*, **39**, 2004, 4405.
- [4] J. Larminie, A. Dicks, "Fuel Cell Systems Explained", Wiley and Sons Ltd, England, 2003.
- [5] F.Y. Wang, S. Chen, Q. Wang, S. Yu, S. Cheng, *Catalysis Today*, **97**, 2004, 189.
- [6] C. Sun, U. Stimming, *Journal of Power Sources*, **171**, 2007, 247.

۲۷ نانومتر به ۲۰/۵ نانومتر طی تست آند، دیده می‌شود. نظر به اینکه حفظ مشخصه نانومتری نانوذرات، تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر طول TPB و در نتیجه نرخ واکنش اکسیداسیون سوخت (در اینجا هیدروژن) دارد، بنابراین با ره‌آورد این تحقیق، می‌توان به تاثیر شایان توجه احداث نانوسازه پالادیمی به روش آغشته‌سازی روی ساختار میکرونی آند متداول Ni/GDC و ارتقاء کارآیی آند میکرونی Ni/GDC برای کاربرد LT-SOFC پی برد.

۴- نتیجه‌گیری

به کمک مطالعات ریزساختاری، تاثیر نانوساختارسازی Pd به روش آغشته‌سازی، بر کارآیی آند Ni/GDC برای واکنش اکسیداسیون H_2 در دمای LT-SOFC، به تفصیل بررسی شد. در بارگذاری کم، پراکندگی مجزای نانوذرات همگام با رشد دانه، منجر به افزایش مقاومت Pd پلاریزاسیون آندی شد. با ادامه بارگذاری Pd تا نیل به نانوساختار پیوسته‌ای روی تمامی سطح آند، به دلیل کاهش اندازه نانوذرات، مقاومت پلاریزاسیون آندی، بطور قابل توجهی (نزدیک به ۱۰۰ درصد) کاهش یافت. بررسی‌ها نشان داد که شبکه‌ای از نانوذرات PdO و

- [29] S.P. Jiang, L. Zhang, H. He, *ECS Transactions*, **25**, 2009, 2067.
- [30] A. Babaei, S.P. Jiang, J. Li, *Journal of the Electrochemical Society*, **156**, 2009, B1022.
- [31] M. Peruffo, P. Contreras-Carballada, P. Bertoncello, R.M. Williams, L.D. Cola, R.J. Forster, P.R. Unwin, *214th Meeting of ECS-Honolulu, Hawaii*, October 2008.
- [32] C.H. Lopus, "Chemical Thermodynamics of Materials", Elsevier Science publishing Co., New York, 1983.
- [33] National Institute of Standards and Technology, U.S. NIST X-ray Photoelectron Spectroscopy Database XPS, NIST Standard Reference Database 20, version 4.1, 2012, Available from: <http://srdata.nist.gov/xps/selEnergyType.aspx>.
- [34] P.A. Simonov, S.Y. Troitskii, V.A. Likhobov, *Kinetics and Catalysis*, **41**, 2000, 255.
- [35] T. Lear, R. Marshall, J.A. Lopez-Sanchez, S.D. Jackson, T.M. Klapotke, M. Baumer, G. Rupprechter, H.J. Freund, D. Lennon, *Journal of Chemical Physics*, **123**, 2005, 174706.
- [36] H.F. Wang, W.E. Kaden, R. Dowler, M. Sterrer, H.J. Freund, *Physical Chemistry Chemical Physics*, **14**, 2012, 11525.
- [37] E.M. Slavinskaya, O.A. Stonkus, R.V. Gulyaev, A.S. Ivanova, V.I. Zaikovskii, P.A. Kuznetsov, A.I. Boronin, *Applied Catalysis A: General*, **401**, 2011, 83.
- [38] K.S. Blinn, X. Li, M. Liu, L.A. Bottomley, M. Liu, *Journal of Visualized Experiments*, **67**, 2012, e50161.
- [39] C. Guizard, A. Princivalle, *Catalysis Today*, **146**, 2009, 367.
- [40] A. Faes, A. Hessler-Wyser, A. Zryd, J.V. Herle, *Membranes*, **2**, 2012, 585.
- [41] P.R. Shearing, R.S. Bradley, J. Gelb, F. Tariq, P.J. Withers, N.P. Brandon, *Solid State Ionics*, **216**, 2012, 69.
- [42] A. Faes, Q. Jeangros, J.B. Wagner, T.W. Hansen, J. Van Herle, A. Briss, R. Dunin-Borkowski, A. Hessler-Wyser, *ECS Transactions*, **25**, 2009, 1985.
- [43] L. Dong, T. Nypelo, M. Osterberg, J. Laine, M. Alava, *Langmuir*, **26**, 2010, 14563.
- [44] S. Hasda, B.S. Thesis, National Institute of Technology Rourkela, Rourkela, 2011.
- [45] T.A. Utigard, M. Wu, G. Plascencia, T. Marin, *Chemical Engineering Science*, **60**, 2005, 2061.
- [46] D.K. Niakolas, M. Athanasiou, S.G. Neophytides, S. Bebelis, *ECS Transaction*, **35**, 2011, 1329.
- [47] V. Sharma, Q. Liu, R. Sharma, P.A. Crozier, *Microscopy and Microanalysis*, **18**, 2012, 1128.
- [48] I. Barin, *Thermochemical Data of Pure Substances*, VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim, 1995.
- [7] J.W. Fergus, *Solid State Ionics*, **177**, 2006, 1529.
- [8] A. Boden, J. Di, C. Lagergren, G. Lindbergh, C.Y. Wang, *Journal of Power Sources*, **172**, 2007, 520.
- [9] R.J. Gorte, J.M. Vohs, *Current Opinion in Colloid & Interface Science*, **14**, 2009, 236.
- [10] W.Z. Zhu, S.C. Deevi, *Materials Science and Engineering A*, **362**, 2003, 228.
- [11] Y. Ji, J. Liu, T. He, J. Wang, W. Su, *Journal of Alloys and Compounds*, **389**, 2005, 317.
- [12] T.S. Zhang, J. Ma, H.T. Huang, P. Hing, Z.T. Xia, S.H. Chan, J.A. Kilner, *Solid State Sciences*, **5**, 2003, 1505.
- [13] N.P. Brandon, D.J. Brett, *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, **364**, 2006, 147.
- [14] S.P. Jiang, *Materials Science and Engineering A*, **418**, 2006, 199.
- [15] J.B. Wang, J.C. Jang, T.J. Huang, *Journal of Power Sources*, **122**, 2003, 122.
- [16] C. Fu, S.H. Chan, Q. Liu, X. Ge, G. Pasciak, *International Journal of Hydrogen Energy*, **35**, 2010, 301.
- [17] C. Timurkutluk, B. Timurkutluk, B. Ibrahimoglu, M.D. Mat, I. Pamuk, Y. Kaplan, *ECS Transactions*, **25**, 2009, 559.
- [18] B. Timurkutluk, C. Timurkutluk, M.D. Mat, *International Journal of Energy Research*, **35**, 2011, 1048.
- [19] S.P. Jiang, *International Journal of Hydrogen Energy*, **37**, 2012, 449.
- [20] Z. Liu, D. Ding, B. Liu, W. Guo, W. Wang, C. Xia, *Journal of Power Sources*, **196**, 2011, 8561.
- [21] H. Kurokawa, L. Yang, C.P. Jacobson, L.C. De Jonghe, S.J. Visco, *Journal of Power Sources*, **164**, 2007, 510.
- [22] U. (Balu) Balachandran, S. -J. Song, C. Y. Park, T. H. Lee, S. E. Dorris, "Hydrogen Production by NG and Renewable Liquids Reforming using Dense Ceramic Membranes", in "Bio-Derived Liquids to Hydrogen Distributed Reforming Working Group (BILIWG), Hydrogen Separation and Purification Working Group (PURIWG) & Hydrogen Production Technical Team Research Review", DOE Hydrogen Program, FY 2007 Annual Progress Report, November 6-7, 2007, 48.
- [23] S.P. Jiang, S. Zhang, Y.D. Zhen, A.P. Koh, *Electrochemical and Solid-State Letters*, **7**, 2004, A282.
- [24] E. Antolini, *Energy and Environmental Sci.*, **2**, 2009, 915.
- [25] U.S. Geological Survey, "Mineral commodity summaries" Reston, Virginia, 2011,
- [26] B.D. Adams, A. Chen, *Materials Today*, **14**, 2011, 282.
- [27] S.K. Ryi, A. Li, C.J. Lim, J.R. Grace, *International Journal of Hydrogen Energy*, **36**, 2011, 9335.
- [28] R.J. Gorte, J.M. Vohs, *Solid State Ionics*, **175**, 2004, 1.